

半導体ウエハ表面研磨温度測定

- 装置組込に適したコンパクトな検出部
- 温度変化に追従性可能な高速応答

半導体ウエハの研磨装置では、サセプタと同じ高さになるまでウエハを研磨することにより所定の厚さにしています。研磨開始直後はウエハとサセプタ間で温度差が生じますが、ウエハがサセプタと同じ高さになると温度の差がなくなります。放射温度計で研磨面の温度を測定することにより、研磨終了の判断が可能となります。

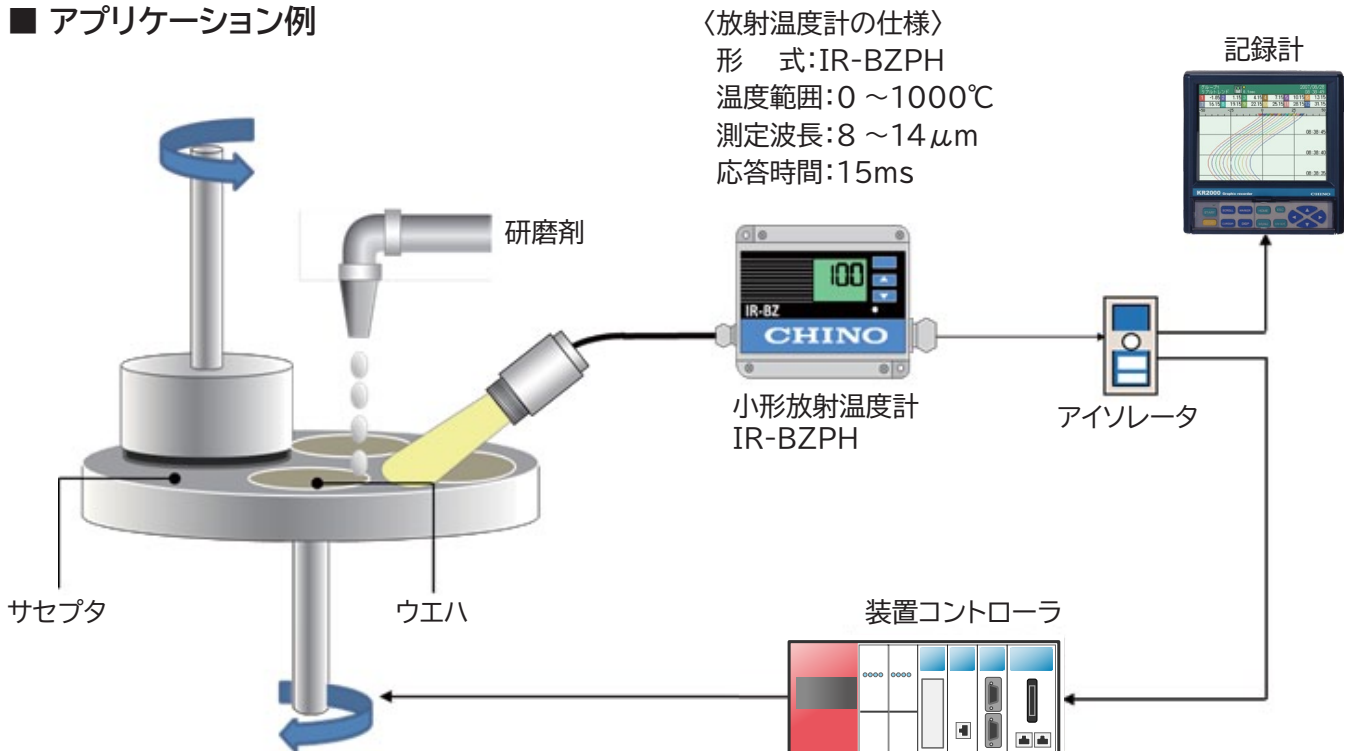
■ 導入効果

- 研磨状況を温度で判断可能
- フィードバックによる加工プロセスの最適化

■ 製品の特長

- 装置組込に適したコンパクトな検出部
- 微細な温度変化に追従可能な高速応答

■ アプリケーション例



※この資料の記載内容は2018年8月現在のものです。